

# 2SD762, 2SD762A

シリコン NPN 三重拡散接合形 / Si NPN Triple Diffused Junction

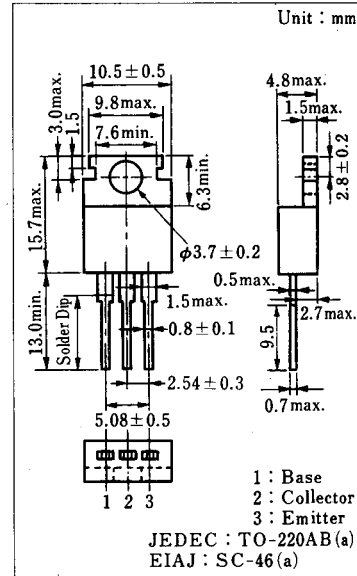
低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

■ 特徴 / Feature

- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB0</sub>	2SD762 60	V
2SD762A 80			
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	2SD762 60	V
2SD762A 80			
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	8	V
せん頭コレクタ電流	I <sub>CP</sub>	6	A
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	4	A
ベース電流	I <sub>B</sub>	1	A
コレクタ損失 (Tc=25 °C)	P <sub>C</sub>	30	W
接合部温度	T <sub>J</sub>	150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =20 V, I <sub>E</sub> =0			30	μA
エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =8 V, I <sub>C</sub> =0			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO(sus)*2</sub>	I <sub>C</sub> =0.2 A, L=25 mH	2SD762	60		V
			2SD762A	80		V
直流電流増幅率	h <sub>FE1</sub>	V <sub>CE</sub> =3 V, I <sub>C</sub> =0.1 A	40			
	h <sub>FE2</sub> *1	V <sub>CE</sub> =3 V, I <sub>C</sub> =1 A	30		160	
ベース・エミッタ電圧	V <sub>BE</sub>	V <sub>CE</sub> =3 V, I <sub>C</sub> =1 A			1.2	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =2 A, I <sub>B</sub> =0.4 A			1	V
しゃ断周波数	f <sub>αc</sub>	V <sub>CE</sub> =10 V, I <sub>C</sub> =0.2 A		25		kHz

\*1 h<sub>FE2</sub> ランク分類 / h<sub>FE2</sub> Classifications

Class	Q	P	O
h <sub>FE2</sub>	30~60	50~100	80~160

\*2 V<sub>CEO(sus)</sub> 測定回路 / V<sub>CEO(sus)</sub> Test Circuit

